ПИЯФ

**Локализованные и распространяющиеся
возбуждения в спиновых жидкостях с
разупорядоченными обменами**

Утёсов О.И., Сизанов А.В., Сыромятников А.В.

Спин-жидкостные магнетики в магнитном поле

Димерные магнетики

Магнетики с целым спином и большой одноионной анизотропией типа легкая плоскость

$$\mathcal{H} = \sum_i \mathcal{J} \mathbf{S}_{i,1} \cdot \mathbf{S}_{i,2} + \sum_m \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} (\mathbf{S}_{i,1} \cdot \mathbf{S}_{j,1} + \mathbf{S}_{i,2} \cdot \mathbf{S}_{j,2}) - h \sum_i (S_{i,1}^z + S_{i,2}^z), \mathcal{J} \gg |J_{ij}|$$

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j + \mathcal{D} \sum_i (S_i^z)^2 - h \sum_i S_i^z, \mathcal{D} \gg |J_{ij}|$$

Спектр элементарных возбуждений во всех фазах со щелью

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \Delta + \frac{1}{2} (J_{\mathbf{k}} - J_{\mathbf{k}_0})$$

Вблизи минимума спектра $\varepsilon_{\mathbf{k}} = \Delta + \frac{1}{2} |J| \kappa^2, \kappa = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$

Мотивация

L. Pollet, N.V. Prokof'ev, B.V. Svistunov, and M. Troyer, Phys. Rev. Lett. **103**, 140402 (2009) – *прямой квантовый фазовый переход между сверхтекучей фазой и моттовским изолятором в бозонных системах с замороженным беспорядком невозможен*

Нейтронные экспериментальные данные (например для $\text{IPA-Cu}(\text{Cl}_x\text{Br}_{1-x})_3$ и $(\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2)\text{Cu}_2(\text{Cl}_x\text{Br}_{1-x})_6$) интерпретируются, как если бы все возбуждения в зоне оставались распространяющимися в системе с разупорядоченными обменами

Мы предлагаем анализ всех щелевых фаз в 1D, 2D и 3D случаях магнетиков с разупорядоченными обменами

Методы

Приближение Т-матрицы

Поправки к наблюдаемым в первом порядке по концентрации c

Функция Грина системы с дефектами

$$G(\mathbf{k}, E) = \frac{1}{E - \varepsilon_{\mathbf{k}} - cT(\mathbf{k}, E)}$$

Т-матрица для беспорядка только в J и $\mathcal{D}$:

$$T(\mathbf{k}, E) = \frac{u}{1 - uG_{00}(E)}, \text{ где}$$

G_{ij} – координатная функция Грина чистой системы,
 $u=J_{\text{imp}}-J$ или $u=\mathcal{D}_{\text{imp}}-\mathcal{D}$

Плотность состояний

$$g(E) = g_0(E) - c \frac{u^2 g_0(E) \Re(dG_{00}/dE) + u(1 - u\Re(G_{00}(E))) dg_0/dE}{[(1 - u\Re(G_{00}(E)))^2 + (\pi u g_0(E))^2]}$$

Численный анализ (только для 1D и 2D)

- Случайное распределение дефектов
- Точная диагонализация гамильтониана (до 15000 ячеек)
- Усреднение по большому числу конфигураций (вплоть до 10^5)

Одномерные системы

Спектр чистых систем

$$\varepsilon_k = \Delta + |J| + J \cos k,$$

где $\Delta = \mathcal{J} - \hbar - |J|$ для фазы в небольших магнитных полях

Спектр и затухание для беспорядка в J или $\mathcal{D}$

$$E_k = \Delta + |J| + J \cos k + c \frac{uJ^2 \sin^2 k}{J^2 \sin^2 k + u^2},$$

$$\gamma_k = c \frac{u^2 |J \sin k|}{J^2 \sin^2 k + u^2}$$

$$E_k = \Delta + \left(\frac{|J|}{2} + c \frac{J^2}{u} \right) \kappa^2, \quad \gamma_k = c |J| \kappa$$

Данные формулы неприменимы вблизи краев зоны: $\kappa \gg c$

Изолированный уровень появляется при любом $\mathcal{U}$, соответствующая поправка для плотности состояний:

$$g(E) = c \delta(E - E_d),$$

$$E_d = \Delta + |J| + \text{sign}(u) \sqrt{J^2 + u^2}$$

Плотность состояний

Одномерные системы

Состояния вблизи краев зон локализованы

Двумерные системы

Спектр чистой системы

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \Delta + 2|J| + J(\cos k_x + \cos k_y)$$

Спектр и затухание для беспорядка в J или $\mathcal{D}$

$$E_{\mathbf{k}} = \Delta + \frac{|J|}{2} \kappa^2 + c \frac{\pi|J|(\pi|J| - u \ln \kappa + 5u \ln 2/2)u}{(\pi|J| - u \ln \kappa + 5u \ln 2/2)^2 + (\pi u/2)^2}$$

$$\gamma_{\mathbf{k}} = c \frac{\pi^2}{2} \frac{|J|u^2}{(\pi|J| - u \ln \kappa + 5u \ln 2/2)^2 + (\pi u/2)^2}$$

Область применимости: $\kappa \gg \sqrt{c}$

Влияние дефектов на плотность состояний: уровень появляется при любом u

Локализация возбуждений в 2D-случае

Состояния вблизи краев зон локализованы

Трехмерные системы

Спектр чистой системы

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \Delta + 3|J| + J(\cos k_x + \cos k_y + \cos k_z)$$

Спектр и затухание для беспорядка в J или $\mathcal{D}$

$$E_{\mathbf{k}} = \Delta + \frac{|J|}{2} \kappa^2 + c \frac{2|J|u}{2|J| + u}, \quad \gamma_{\mathbf{k}} = c\kappa \frac{1}{\pi} \frac{2|J|u^2}{(2|J| + u)^2}, \quad \text{область применимости: } \kappa \gg \sqrt{c}$$

В случае $|2|J| + u| \ll |u|$ затухание сильно растет: $\gamma_{\mathbf{k}} \sim c/\kappa$ -

- **резонансное рассеяние**

В отличие от 1D и 2D систем, в трехмерном случае примесный уровень появляется при $|u| > 2|J|$

$$c = 0.1, u = 3|J|$$

Выводы

- Нами была разработана теория для описания фаз со щелью одно-, дву- и трех-мерных систем с разупорядоченными обменами и слабовзаимодействующими бозонными элементарными возбуждениями, основанную на приближении T-матрицы
- Мы получили выражения для поправок к спектрам элементарных возбуждений и их затухания в первом порядке по концентрации дефектов
- Мы обнаружили, что аналитическое приближение неприменимо для состояний вблизи краев зоны. Численный анализ показал локализованную природу этих состояний
- Были получены условия, при которых появляются изолированные уровни
- Обнаружено, что в рассмотренных системах отношение $\gamma_{\mathbf{k}}/\epsilon_{\mathbf{k}}$ для распространяющихся возбуждений может достигать c/k^2 , что значительно больше, чем в магнитоупорядоченных кристаллах

Спасибо за внимание!